

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】 第 6 部門第 2 区分

【発行日】 平成 18 年 1 月 12 日 (2006.1.12)

【公開番号】 特開 2001-194793 (P2001-194793A)

【公開日】 平成 13 年 7 月 19 日 (2001.7.19)

【出願番号】 特願 2000-310728 (P2000-310728)

【国際特許分類】

G 0 3 F 7/039 (2006.01)

C 0 8 F 212/14 (2006.01)

C 0 8 K 5/00 (2006.01)

C 0 8 L 25/18 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/039 6 0 1

C 0 8 F 212/14

C 0 8 K 5/00

C 0 8 L 25/18

H 0 1 L 21/30 5 0 2 R

【手続補正書】

【提出日】 平成 17 年 11 月 18 日 (2005.11.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 特許請求の範囲

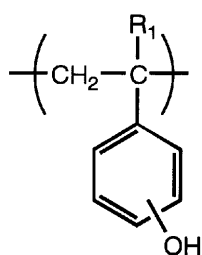
【補正方法】 変更

【補正の内容】

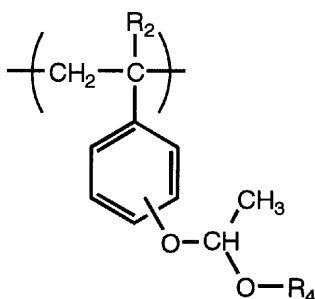
【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (a) 下記一般式 (I)、(II) 及び (III) で表される構造単位を少なくとも有する共重合体 A、(b) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物、及び (c) 溶剤を含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

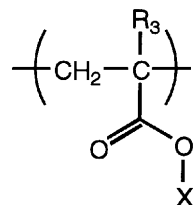
【化 1】



(I)



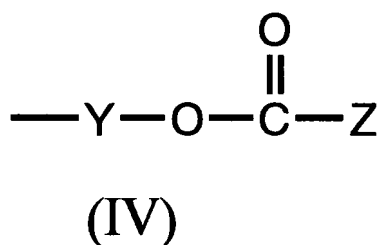
(II)



(III)

式 (I) ~ (II) 中、 R_1 及び R_2 は、互いに独立して水素原子またはメチル基を表し、 R_4 は直鎖状、分岐状もしくは環状の置換基を有してもよいアルキル基、置換基を有してもよいアラルキル基、置換基を有してもよいアリール基または式 (IV) で表される基を表す。

【化 2】

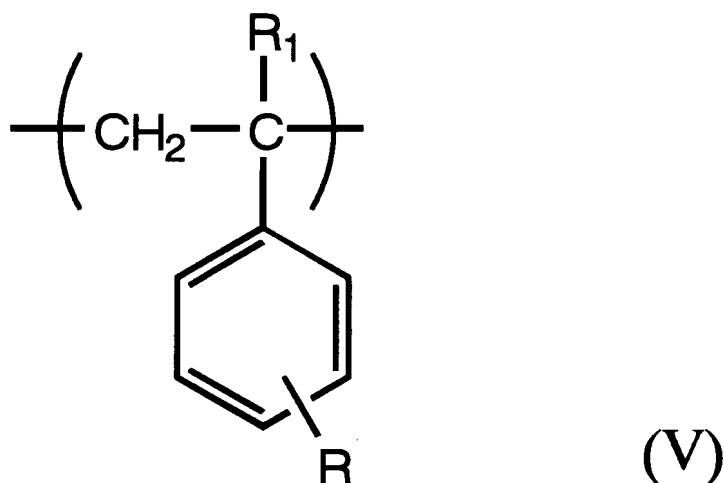


式 (IV) 中、Y は置換されていてもよい炭素数 1 ～ 20 のアルキレン基を表す。
Z は置換されていてもよい炭素数 1 ～ 20 の直鎖状、分岐状もしくは環状アルキル基、置換されていてもよい炭素数 6 ～ 20 のアリール基または置換されていてもよい炭素数 7 ～ 20 のアラルキル基を表す。

式 (III) 中、R₃ は水素原子またはメチル基を表し、X は置換基を有してもよい飽和縮合多環系炭化水素または置換基を有してもよい飽和橋かけ環炭化水素を有する基を表す。

【請求項 2】前記 (a) 共重合体 A が、更に下記一般式 (V) で表される構造単位を含有することを特徴とする請求項 1 記載のポジ型フォトレジスト組成物。

【化 3】



式 (V) 中、R₁ は請求項 1 に記載のものと同義である。R は水素原子、炭素数 1 ～ 4 の直鎖状もしくは分岐状アルキル基、メトキシ基またはアセトキシ基を表す。

【請求項 3】 請求項 1 または 2 に記載のポジ型フォトレジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。